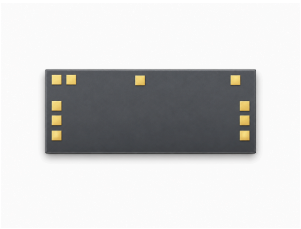
Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 8000–12000 MHz



LCI-PA-8000-12000-PS39T-D — бескорпусной кристалл усилителя мощности GaN MMIC для диапазона 8000–12000 MHz.
Поддерживается импульсный режим.

Параметры таблицы RF: Выходная мощность насыщения: 39 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 18 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 43 % (типовое). Условия измерения RF: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V. Размеры кристалла: 2.3 × 1.15 × 0.1 mm.

RF-параметры

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Рабочая частота	f	8000	-	12000	MHz
Выходная мощность насыщения	Psat	38	39	-	dBm
Коэффициент усиления по мощности	Gp	17	18	-	dB
Неравномерность усиления по мощности	ΔGp	-	-	±0.7	dB
КПД с учётом добавленной мощности	PAE	-	43	-	%
Коэффициент усиления малого сигнала	S21	-	27	29	dB
Неравномерность усиления малого сигнала	ΔS21	-	-	±2	dB
Входной КСВН	VSWR(in)	-	1.6	3	-

Смещение DC и токи

TA = +25 °C

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Напряжение стока	Vd	-	28	32	V
Напряжение затвора	Vg	-3.4	-2.6	-2.4	V
Ток покоя стока	Id	-	0.2	-	A
Динамический ток стока	Idd	-	0.7	0.8	A
Динамический ток затвора	Igg	-	0.2	1	mA

Предельные значения

Предельные значения; не являются нормальными рабочими уставками.

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Максимальное напряжение сток–исток	Vd	-	-	36	V
Минимальное смещение затвора	Vg	-5	-	-	V
Максимальная входная мощность	Pin	-	-	28	dBm
Максимальная температура канала	Top	-	-	225	°C
Температура хранения	TSTG	-65	-	150	°C

Размеры кристалла

Параметр	Значение	Единица
Размеры кристалла	2.3 × 1.15 × 0.1	mm
Допуск контура в плане	±100 (Только контур в плане; допуск толщины не указан.)	µm

Текущая публикация · 1.7 · 2026-11-12. Обновлены описание изделия или редакционные материалы. Заменяет редакцию 1.6.

Монтаж кристалла и последовательность смещения

При включении сначала подают смещение затвора, затем стока. При выключении сначала снимают смещение стока. Требуются чистая рабочая среда, защита от ESD и держатель с тепловым расширением, совместимым с кристаллом SiC.

Размеры контактных площадок

Обозначение: RFin; Размеры (µm): 100 × 100. Обозначение: Vg; Размеры (µm): 100 × 100. Обозначение: Vd1; Размеры (µm): 100 × 100. Обозначение: Vd2; Размеры (µm): 100 × 100. Обозначение: RFout; Размеры (µm): 100 × 100.

Габаритный чертеж

Контур и координаты с нанесёнными размерами в mm. Чертёж предназначен для справки по размерам. Для изготовления и проволочной разварки нужны полные чертежи.

LCI-PA-8000-12000-PS39T-D



X (mm)
Vg: 0.270
Vd1: 1.024
Vd2: 2.070

Y (mm)
RFin / RFout: 0.510

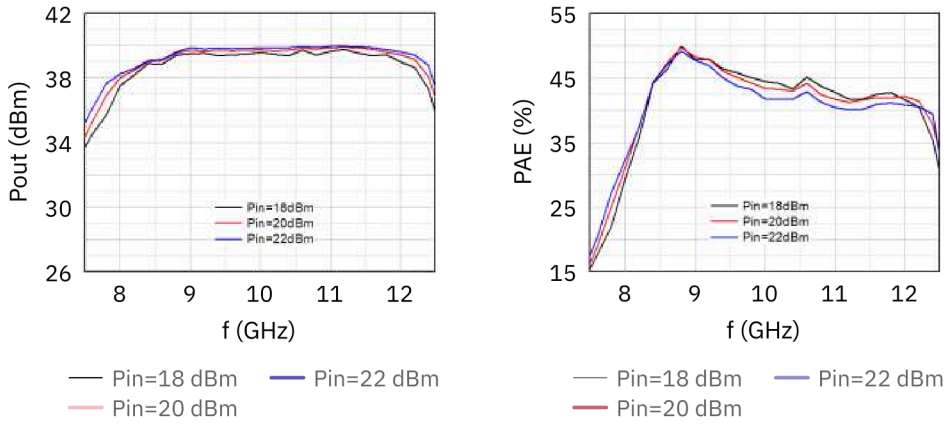
2.300 × 1.150 × 0.100 mm
X, Y: ±0.100 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

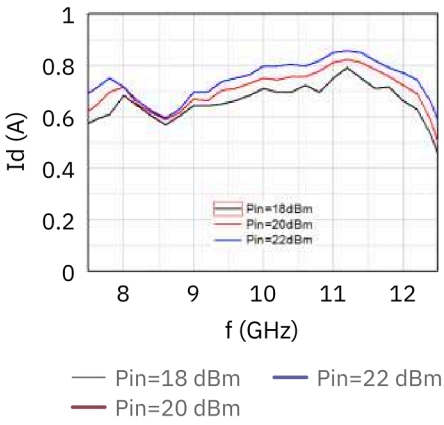
Характеристики

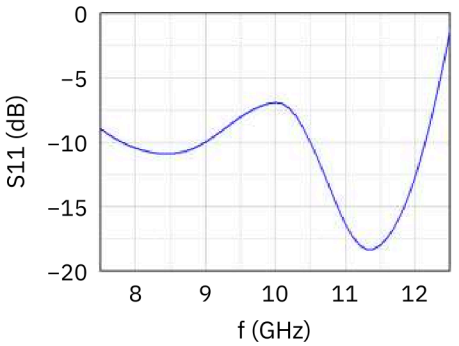
Каждый график показывает характеристики при указанных на нём рабочих условиях.

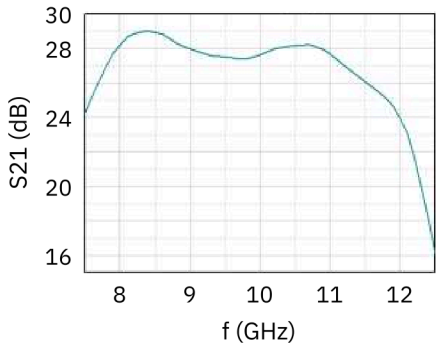
Выходная мощность; КПД с учётом добавленной мощности; Ток стока; Коэффициент усиления малого сигнала; Согласование входа.

Примечания к графику: Vd=+28V; Vg=-2.6V. (1–3): Pin = 18 / 20 / 22 dBm. Условия относятся к указанным графикам и их собственным легендам.









Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.